

技术规格书

High-power Single Emitter Diode Lasers, 660nm, 2W cw

660nm 2W 高功率巴条激光芯片

产品型号 DG-UMC-110-660-TE-2-1.5

性能参数 Performance Parameters	符号 Symbol	最小值 Minimum	典型值 Typical	最大值 Maximum	单位 Unit
光学性能 Optical					
输出功率 Optical output power	P _o		2		W
中心波长 Wavelength	λ _c	660	665	670	nm
工作模式 Operation mode			CW		
电学性能 Electrical					
电光转换效率 E-O conversion efficiency	η _c	25	30		%
斜率效率 Slope efficiency	SE	0.75	0.84		W/A
阈值电流 Threshold current	I _{th}		0.4	0.6	A
工作电流 Operating current	I _{op}		2.8	3.0	A
工作电压 Operating voltage	V _{op}		2.3	2.5	V
光谱宽度 Spectral width (FWHM)	Δλ		1.0	1.5	nm
波长温度系数 Wavelength temperature coefficient	Δλ/ΔT		0.3	0.5	nm/°C
水平远场发散角(95E%) Horizontal F.F.divergence angle	θ _∥				Deg
垂直远场发散角(95E%) Vertical F.F. divergence angle	θ _⊥				Deg
几何尺寸 Geometrical					
发光区宽度 Emitter width	E.W.	105	110	115	μm
腔长 Cavity length	L	1480	1500	1520	μm
宽度 Width	W	280	300	320	μm
厚度 Thickness	D	105	115	125	μm

备注：本参数为产品进行 COS 封装，CW 电流模式，导热板 25°C 条件下的测试参数。

Note: These parameters were obtained by testing COS packaged products in the CW mode at 25°C.



变更记录

版本	日期	变更记录	制 修订人	批准人
V1				